

ELEKTRONIKA

Predavanje 12
POJAČALA S UNIPOLARNIM TRANZISTORIMA
DINAMIČKI UVJETI RADA
FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE POJAČALA

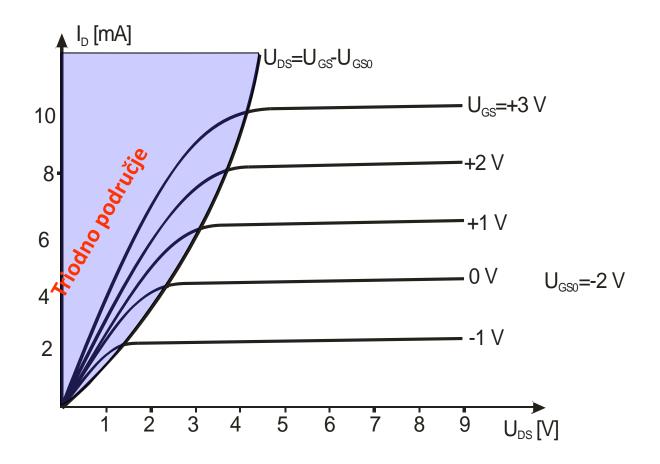
Definicija statičkih uvjeta



- MOSFET-ovi osiromašenog tipa mogu raditi i s negativnim i s pozitivnim naponom na upravljačkoj elektrodi.
- Zajedničko svojstvo svih FET-ova: vrlo visok ulazni otpor između upravljačke elektrode (vrata) i uvoda.
- Upravljanje se vrši naponskim signalom.

Izlazne karakteristike FET-a

 Izlazne statičke karakteristike idealnog n-kanalnog MOSFET-a osiromašenog tipa:



Triodno područje

 Lijevo od krivulje U_{DS}=U_{GS}-U_{GSO} je triodno područje – struja odvoda I_D raste s naponom U_{DS}, uz stalan iznos napona U_{GS} prema izrazu:

$$I_{D} = K \left[(U_{GS} - U_{GS0})U_{DS} - \frac{1}{2}U_{DS}^{2} \right]$$
 (1)

• K je konstanta MOSFET-a određena izrazom:

$$K = \mu_0 \frac{\mathcal{E}_{0x}}{t_{0x}} \cdot \frac{w}{L} \tag{2}$$

gdje je μ_0 površinska pokretljivost slobodnih elektrona u kanalu između uvoda i odvoda, ϵ_{0x} je dielektrička konstanta, t_{0x} je debljina sloja SiO_2 iznad područja kanala, w je širina, a L duljina kanala.

Područje zasićenja

 Zbog pojava na površini silicija i na međupovršini između silicija i oksidnog sloja površinska je pokretljivost manja od volumne.

Područje karakteristika gdje je U_{DS}>U_{GS}-U_{GS0} opisano je jednadžbom:

 $I_D = \frac{K}{2} (U_{GS} - U_{GS0})^2 \tag{3}$

• Pri naponu $U_{GS}=0$ struja $I_D=\frac{K}{2}(-U_{GS0})^2=I_{DSS}$ pa se relacija (3) može pisati kao:

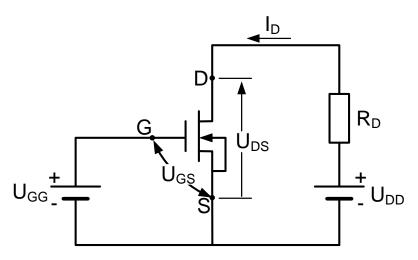
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{U_{GS}}{U_{GS0}} \right)^2 \tag{4}$$

 Struja I_{DSS} je struja odvoda u području zasićenja pri naponu U_{GS}=0.

Područja rada FET-a

- Triodno područje područje relativno malog iznosa dinamičkog otpora.
- U triodnom se području idealni FET ne može u izlaznom krugu tretirati ni kao idealni naponski ni kao idealni strujni izvor.
- Područje zasićenja područje konstantne struje odvoda pri konstantnom naponu U_{GS}, idealni FET se u tom području ponaša kao idealni strujni izvor.
- Da bi se MOSFET doveo u statičku radnu točku u području zasićenja, potrebno je osigurati odgovarajuće napone U_{DS} i U_{GS}:

Statički uvjeti rada MOSFET-a

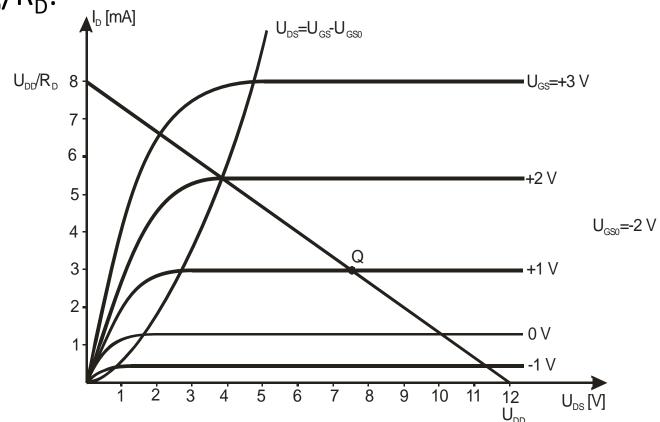


n-kanalni MOSFET. Definicija statičkih uvjeta.

- Pozitivan predznak napona $U_{GS}=U_{GG}$ znači da n-kanalni MOSFET osiromašenog tipa radi u obogaćenom modu. Ako bi U_{GG} bio negativan, MOSFET bi radio u osiromašenom modu. $U_{DD}=U_{DS}+I_{D}\cdot R_{D}$ (5)
- Iz izlaznog kruga slijedi jednadžba radnog pravca:

Statički radni pravac i statička radna točka FET-a

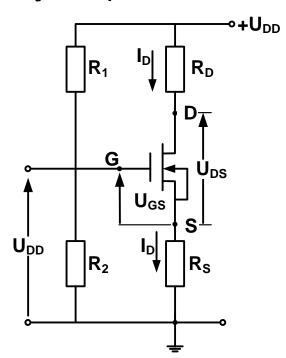
 Odsječak radnog pravca na apscisi je U_{DD}, a na ordinati U_{DD}/R_D:



U odabranoj statičkoj radnoj točki napon U_{GS}=+1 V.

Praktična izvedba sklopa za podešavanje DC uvjeta

 Praktična izvedba sklopa za podešavanje istosmjernih uvjeta (statičke radne točke):



Budući da je istosmjerna struja vrata jednaka nuli, istosmjerni napon U_{GG} iznosi:

$$U_{GG} = U_{DD} \frac{R_2}{R_1 + R_2} \tag{6}$$

Za ulazni krug sklopa (krug vrata-uvod) vrijedi jednadžba naponske ravnoteže:

$$U_{GG} = U_{GS} + I_D \cdot R_S \tag{7}$$

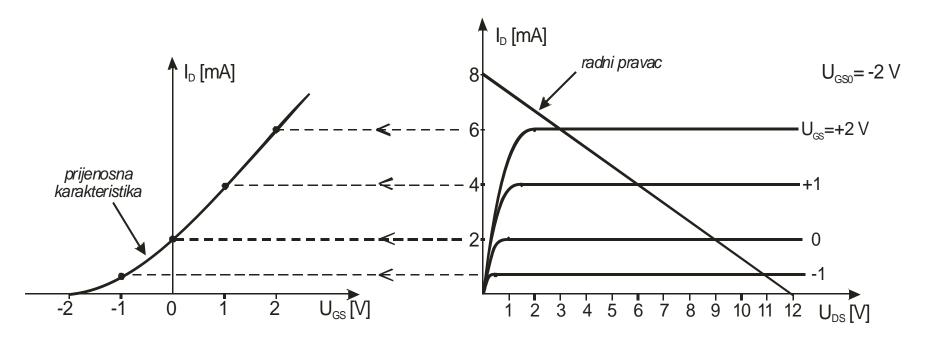
Napon U_{GG} , odnosno potencijal elektrode G prema uzemljenoj točki je stalan i određen je relacijom (6). Stoga svaka promjena potencijala točke S (uvoda) prema uzemljenju uvjetuje odgovarajuću promjenu napona U_{GS} , odnosno struje I_{D} .

Izlazni krug FET-a u statičkim uvjetima

Za izlazni krug sklopa na slici vrijedi jednadžba naponske ravnoteže:

$$U_{DD} = I_D (R_D + R_S) + U_{DS} \tag{8}$$

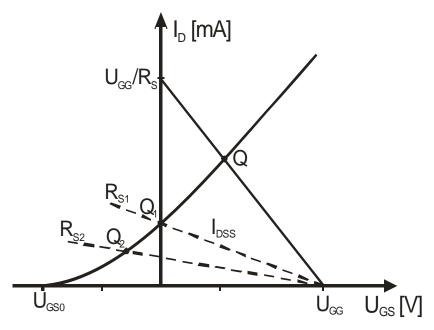
Koja je ujedno i jednadžba radnog pravca u polju izlaznih karakteristika. Pomoću radnog pravca i izlaznih karakteristika može se odrediti prijenosna karakteristika:



Utjecaj otpora R_S na položaj SRT-e

• Jednadžba (7) je ujedno jednadžba radnog pravca u polju prijenosne karakteristike. Odsječak radnog pravca na apscisi je U_{GG} , a na ordinati U_{GG}/R_{S} .

 Statička radna točka Q određena je sjecištem radnog pravca i prijenosne karakteristike.



- Promjena statičke radne točke promjenom otpora R_s.
- Q₁ (R_{S1}>R_S, U_{GS}=0) MOSFET je na granici obogaćenog i osiromašenog područja (moda).
- Q_2 (U_{GS} <0) MOSFET je u osiromašenom modu.
- Dakle, R_s omogućava rad i u osiromašenom i u obogaćenom modu.

Dinamička svojstva

• Trenutna totalna vrijednost struje odvoda i_D određena je trenutnim totalnim vrijednostima napona u_{DS} i u_{GS} :

$$i_D = f(u_{DS}, u_{GS}) \tag{9}$$

Totalni diferencijal struje i_D je:

$$di_D = \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} du_{DS} + \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} du_{GS}$$
 (10)

• Diferencijale du_{GS} , du_{DS} i di_{D} moguće je aproksimirati konačnim, ali dostatno malim prirastima Δu_{GS} , Δu_{DS} i Δi_{D} . Male, ali konačne priraste trenutnih vrijednosti veličina u_{GS} , u_{DS} i i_{D} možemo uzeti kao trenutne vrijednosti malih izmjeničnih veličina:

Dinamička svojstva (2)

$$di_{D} \approx \Delta i_{D} \approx i_{d}$$

$$du_{DS} \approx \Delta u_{DS} \approx u_{ds}$$

$$du_{GS} \approx \Delta u_{GS} \approx u_{gs}$$
(11)

• S obzirom na (11), (10) se može pisati u obliku:

$$i_d = \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} u_{ds} + \frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}} u_{gs}$$
 (12)

• Veličina $\frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}}$ je recipročna vrijednost dinamičkog otpora u određenoj statičkoj radnoj točki:

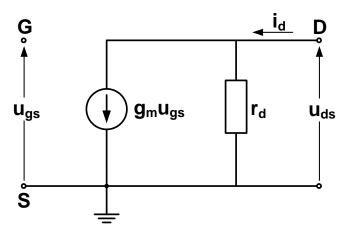
$$\frac{1}{r_d} = \frac{\partial i_D}{\partial u_{DS}} \Big|_{U_{GSQ}} \approx \frac{\Delta I_D}{\Delta U_{DS}} \Big|_{U_{GSQ}} \approx \frac{i_d}{u_{ds}} \Big|_{U_{GSQ}} \tag{13}$$

Dinamički uvjeti (3)

- Veličina $\frac{\partial i_D}{\partial u_{GS}}$ je strmina g_m.
 Konačno se (12) može pisati kao:

$$i_d = g_m u_{gs} + \frac{1}{r_d} u_{ds} {14}$$

Na temelju relacije (14) može se u uvjetima malih izmjeničnih signala i srednjih frekvencija nacrtati nadomjesni sklop:



Dinamički uvjeti (4)

 Množenjem lijeve i desne strane jednadžbe (14) s veličinom r_d dobiva se:

$$i_d \cdot r_d = g_m \cdot r_d \cdot u_{gs} + u_{ds} \tag{15}$$

• Umnožak $g_m r_d$ označava se simbolom μ i poznat je kao faktor pojačanja, a sama jednadžba

$$g_m \cdot r_d = \mu \tag{16}$$

kao Barkhausenova jednadžba.

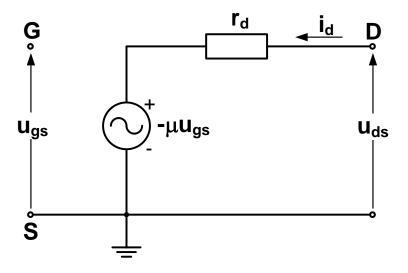
Dakle, (15) se može pisati kao

$$u_{ds} = -\mu \cdot u_{gs} + i_d \cdot r_d \tag{17}$$

• Na temelju relacije (17) može se nacrtati nadomjesni sklop za mali izmjenični signal s naponskim izvorom.

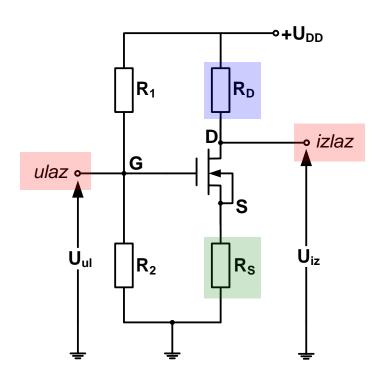
Nadomjesni sklop MOSFET-a za mali izmjenični signal

 Nadomjesni sklop MOSFET-a za mali izmjenični signal s naponskim izvorom:



Pojačalo u spoju zajedničkog uvoda

 Izvedba pojačala u spoju zajedničkog uvoda sa stabilizacijom statičke radne točke pomoću otpornika R_s u krugu uvoda.



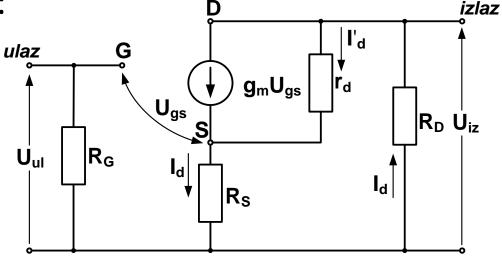
Uvod nije izravno uzemljen već je uzemljen preko otpornika R_s.

Ulazni signal priključen je na vrata (upravljačku elektrodu G), a izlazni signal se uzima s odvoda D.

Otpornik R_D je ujedno i trošilo ako na izlaz sklopa nije uključen neki drugi otpornik.

Nadomjesni sklop pojačala u spoju zajedničkog uvoda

Nadomjesni sklop pojačala sa slike u dinamičkim uvjetima:



- Iz ulaznog kruga sklopa slijedi: $U_{gs} = U_{ul} I_d \cdot R_S$ (18)
- Struja I_d jednaka je: $I_d = I_d + g_m U_{gs}$ (19)

Iz izlaznog kruga sklopa slijedi:

$$I_{d}(R_{D} + R_{S}) + I_{d}'r_{d} = 0 (20)$$

Iz relacija (18)-(20) slijedi izraz za struju odvoda:

$$I_d = \frac{\mu U_{ul}}{R_D + r_d + (1 + \mu)R_s} \tag{21}$$

gdje je $\mu = g_m \cdot r_d$.

- Napon U_{iz} na trošilu R_D iznosi: $U_{iz} = -I_d \cdot R_D$ (22)
- Naponsko pojačanje je po definiciji:

$$A_{V} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = -\frac{I_{d} \cdot R_{D}}{U_{ul}} = -\frac{\mu R_{D}}{R_{D} + r_{d} + (1 + \mu)R_{S}}$$
(23)

- Otpornik R_S u krugu uvoda smanjuje naponsko pojačanje. To je degenerativni utjecaj otpora R_S na naponsko pojačanje sklopa.
- Rješenje: spajanje kondenzatora paralelno otporniku R_s (na frekvenciji izmjeničnog signala kondenzator praktički kratko spaja otpornik).
- Tada naponsko pojačanje slijedi iz (23) uz R_s=0:

$$A_V = -\frac{\mu R_D}{R_D + r_d} \tag{24}$$

- Pojačanje određeno izrazom (24) je veće u odnosu na pojačanje određeno izrazom (23).
- Ako je $\mu >> 1$ i $r_d >> R_D$ relacija (23) svodi se na oblik:

$$A_V \approx -\frac{g_m}{1 + g_m R_S} \cdot R_D = -g_m' \cdot R_D \tag{25}$$

Veličina

$$g_m' = \frac{g_m}{1 + g_m R_s} \tag{26}$$

naziva se efektivna strmina.

Ako je još ispunjen uvjet:

$$g_m R_s >> 1 \tag{27}$$

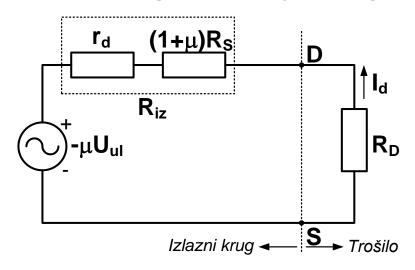
tada (25) prelazi u oblik:

$$A_{V} \approx -\frac{R_{D}}{R_{S}} \tag{28}$$

što znači da naponsko pojačanje ne ovisi o parametrima tranzistora, već o stabilnim pasivnim komponentama (otpornicima) kojima je moguće ostvariti naponsko pojačanje s velikom stabilnošću u širokom rasponu temperatura.

• Izlazni otpor pojačala može se odrediti pomoću relacije (21): $\mu U_{\mu l} = I_{A} [r_{A} + (1 + \mu)R_{S}] + I_{A} \cdot R_{D}$ (29)

i prema njoj nacrtanog nadomjesnog sklopa:



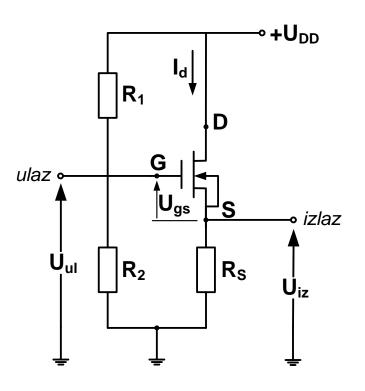
Dakle, izlazni otpor jednak je:

$$R_{iz} = r_d + (1 + \mu)R_S \tag{30}$$

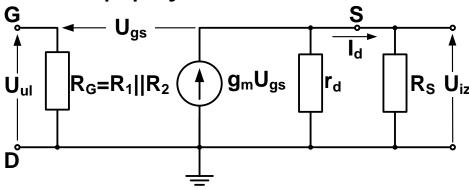
- Degeneracijom uvoda povećava se izlazni otpor za iznos $(1+\mu)R_s$.
- Ako je otpornik R_S premošten kondenzatorom, tada R_{iz} , uz uvjet R_S =0, jednako je: $R_{iz} = r_d$ (31)
- Ulazni otpor jednak je R_G i ne ovisi o degeneraciji uvoda.

Pojačalo u spoju zajedničkog odvoda

Osnovni sklop pojačala u spoju zajedničkog odvoda:



Ulazni signal dovodi se na upravljačku elektrodu G, a izlazni signal se uzima s elektrode uvoda gdje je otpornik R_S ujedno i trošilo sklopa. Nadomjesni sklop pojačala:



• Prema ulaznom krugu osnovnog pojačala može se napisati relacija: $U_{gs} = U_{ul} - U_{iz}$ (32)

Za izlazni krug nadomjesnog sklopa vrijedi relacija:

$$U_{iz} = g_m U_{gs} \left(r_d || R_S \right) \tag{33}$$

 Izraz za naponsko pojačanje sklopa može se odrediti pomoću relacija (32) i (33):

$$A_{V} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{g_{m}(r_{d} \| R_{S})}{1 + g_{m}(r_{d} \| R_{S})}$$
(34)

- Naponsko pojačanje u spoju zajedničkog odvoda je pozitivno, što znači da sklop ne obrće fazu izmjeničnog signala. $r_d >> R_S$ (35)
- Kod realnih sklopova obično je ispunjen uvjet:

$$A_V \approx \frac{g_m}{1 + g_m R_S} \cdot R_S \tag{36}$$

pa se izraz (34) može svesti na jednostavniji oblik:

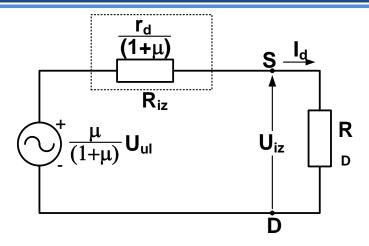
- Ako je uz to ispunjen uvjet $g_m R_s >> 1$, tada je pojačanje A_v približno jednako jedinici.
- Izlazni otpor pojačala može se odrediti na isti način kao i za pojačalo u spoju zajedničkog uvoda.
- Iz izlaznog kruga nadomjesnog sklopa slijedi izraz za struju
 I_d:

$$I_d = \frac{U_{iz}}{R_S} = \frac{A_V U_{ul}}{R_S} \tag{37}$$

Uvrštavanjem izraza za A_v (34) u izraz (37) dobiva se:

$$\frac{\mu}{1+\mu}U_{ul} = I_d \frac{r_d}{1+\mu} + I_d \cdot R_S$$
 (38)

što odgovara nadomjesnom sklopu:



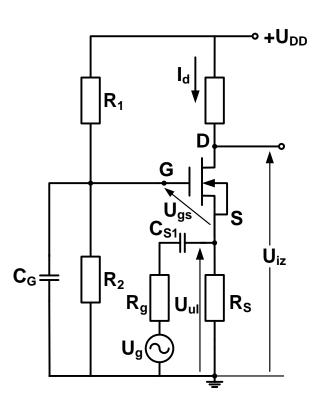
 Dakle, za izlazni otpor pojačala u spoju zajedničkog odvoda može se pisati izraz:

$$R_{iz} = \frac{r_d}{1 + \mu} \tag{39}$$

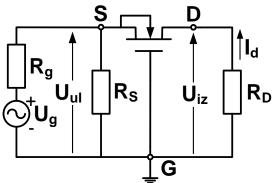
• Kako je redovito μ >>1, izlazni otpor je R_{iz} << r_d .

Pojačalo u spoju zajedničke upravljačke elektrode

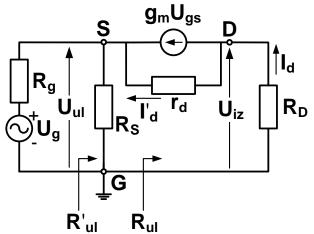
 Osnovni sklop pojačala u spoju upravljačke elektrode (vrata):



Izmjenični ulazni signal dovodi se u krug uvoda, a izlazni signal se uzima s odvoda. Upravljačka elektroda je za izmjenični signal uzemljena preko kondenzatora C_G:



Nadomjesni sklop pojačala u spoju zajedničke upravljačke elektrode:



Za sklop na slici mogu se napisati ove relacije:

$$U_{ul} = U_{iz} - I_d \cdot r_d \tag{40}$$

$$I_{d}^{'} = I_{d} - g_{m} U_{gs} \tag{41}$$

$$U_{iz} = -I_d \cdot R_D \tag{42}$$

$$U_{gs} = -U_{ul} \tag{43}$$

• Na temelju gornjih relacija slijedi izraz za struju odvoda: $(1+\mu)U$

$$I_d = -\frac{(1+\mu)U_{ul}}{r_d + R_D} \tag{44}$$

odnosno naponsko pojačanje:

$$A_{V} = \frac{U_{iz}}{U_{ul}} = \frac{(1+\mu)R_{D}}{r_{d} + R_{D}}$$
 (45)

- Naponsko pojačanje je pozitivan broj što znači da su ulazni i izlazni signal u fazi.
- Nadalje, iz izraza (45) se vidi da naponsko pojačanje raste s otporom trošila od A_v=0 pri R_D=0 do A_v=1+μ pri R_D→∞.
- Ulazni otpor pojačala R_{III} određen je izrazom:

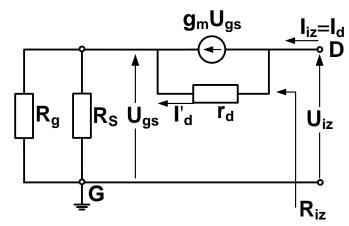
$$R_{ul} = \frac{U_{ul}}{-I_d} = \frac{U_{ul}}{U_{iz}} \cdot R_D = \frac{R_D}{A_V}$$
 (46)

Odnosno

$$R_{ul} = \frac{R_D + r_d}{1 + \mu} \tag{47}$$

$$R_{ul} = R_{ul} \| R_{s} \tag{48}$$

 Izlazni otpor se dobiva kao omjer izlaznog napona i izlazne struje pri kratkospojenom naponu U_g:



Za sklop na slici mogu se napisati jednadžbe:

$$U_{iz} = I_d \cdot r_d + I_d \cdot R_g \tag{49}$$

$$I_d = I_d - g_m U_{gs} \tag{50}$$

$$U_{gs} = -I_{d} \cdot R_{g}$$
 (51)

 Iz navedenih relacija može se odrediti omjer U_{iz}/I_d, odnosno izraz za izlazni otpor sklopa:

$$R_{iz} = \frac{U_{iz}}{I_d} = r_d + (1 + \mu)R_g'$$
 (52)

 Pojačalo u spoju zajedničke upravljačke elektrode ima mali ulazni otpor, a veliki izlazni otpor.

FREKVENCIJSKE KARAKTERISTIKE POJAČALA

3.6.2019.

Frekvencijska područja rada pojačala

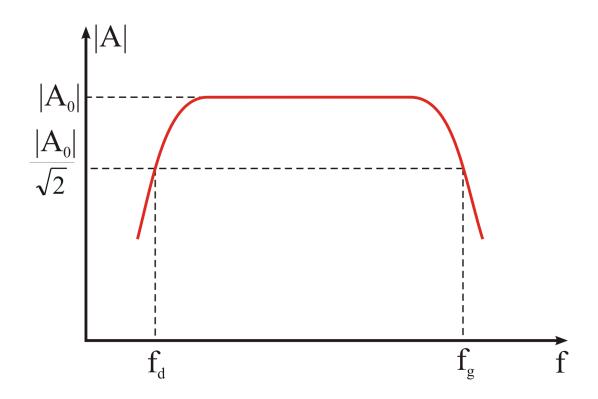
 S obzirom na frekvenciju priključenog signala rad elektroničkih sklopova može se podijeliti u tri frekvencijska područja:

- 1) područje niskih frekvencija
- 2) područje srednjih frekvencija

3) područje visokih frekvencija

Frekvencijska karakteristika pojačala

 Frekvencijska karakteristika pojačala – ovisnost pojačanja o frekvenciji



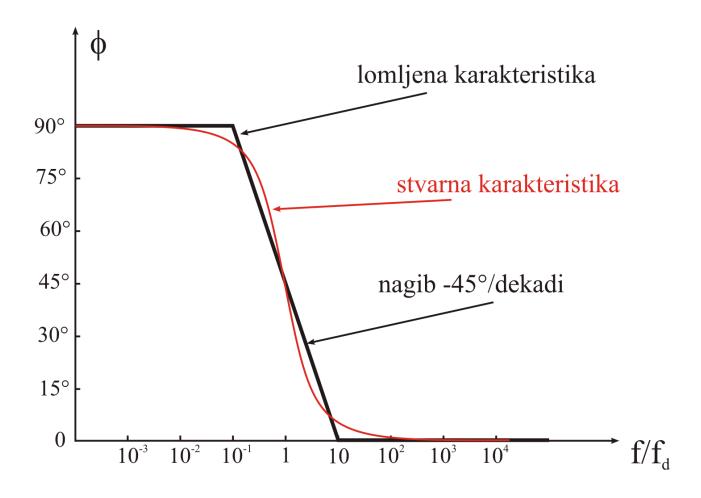
Frekvencijska karakteristika pojačala (2)

- U području srednjih frekvencija pojačanje ne ovisi o frekvenciji (referentno pojačanje A₀).
- U točkama u kojima je vrijednost pojačanja $A_0/\sqrt{2}$ definirane su dvije karakteristične frekvencije: gornja i donja granična frekvencija.
- Postojanje donje granične frekvencije uvjetovano je konstrukcijom sklopa (vezni kondenzatori na ulazu i izlazu pojačala).
- Gornja granična frekvencija je rezultat fizikalnih pojava u radu tranzistora.
- Gornja granična frekvencija može se povećati izborom odgovarajućeg tranzistora i konstrukcijom sklopa, ali je njen iznos uvijek konačan.
- Frekvencijska karakteristika idealnog pojačala bila bi horizontalan pravac.

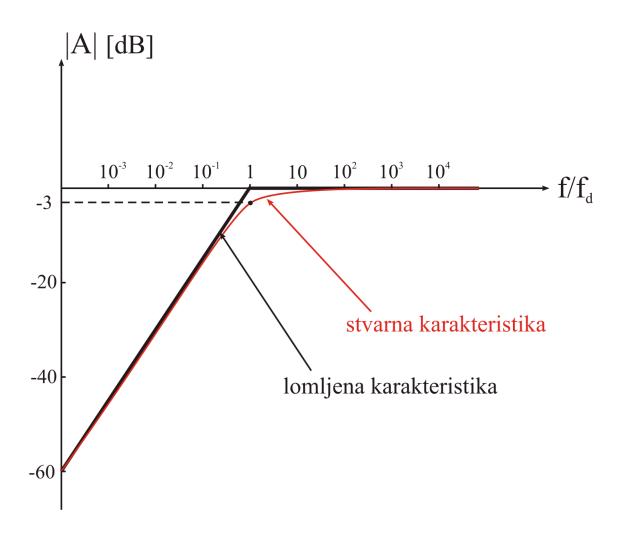
Frekvencijska karakteristika pojačala (3)

 Realna pojačala uvijek unose određeni fazni pomak između izlaznog i ulaznog signala. Taj pomak je posljedica konačnog vremena nabijanja i pražnjenja barijernih kapaciteta, konačnog vremena proleta nosilaca naboja kroz tranzistor i djelovanja vremenskih konstanti pasivnih dijelova pojačala.

Primjer: Jednostavna RC mreža – Fazna karakteristika

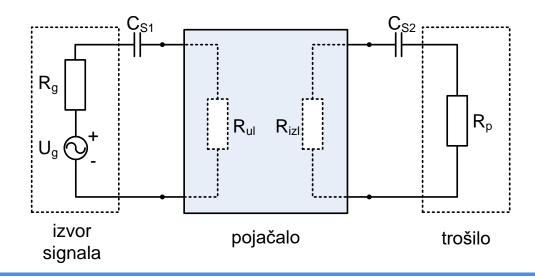


Primjer: Jednostavna RC mreža - amplitudna karakteristika



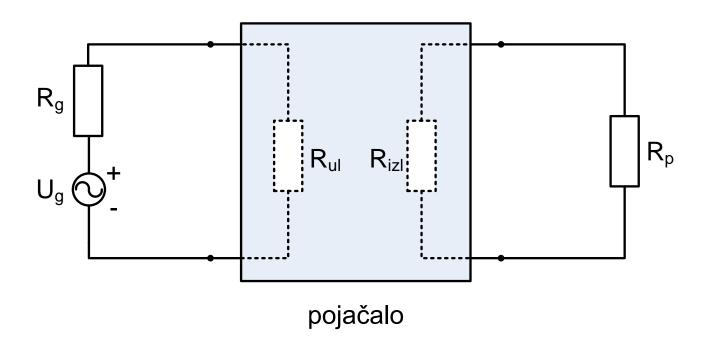
1) Područje niskih frekvencija

- U području niskih frekvencija potrebno je uzeti u obzir pad napona na kondenzatorima koji su serijski vezani u sklopu.
- Na slici je prikazano pojačalo s veznim kondenzatorima C_{S1} i C_{S2} koji u statičkim uvjetima odjeljuju izvor signala i trošilo od sklopa pojačala.



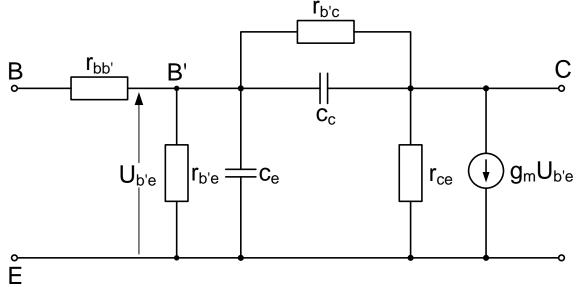
2) Područje srednjih frekvencija

- Mogu se zanemariti utjecaji kapacitivnih komponenata sklopa.
- U dinamičkim uvjetima vezni se kondenzatori u ulaznom i izlaznom krugu pojačala kratko spajaju:



3) Područje visokih frekvencija

 Pojave na visokim frekvencijama moguće je analizirati primjenom Giacolettovog modela tranzistora:



• Giacolettov model (hibridni π -model) uključuje barijernu i difuzijsku kapacitivnost tranzistora koje su ključne za ponašanje tranzistora na visokim frekvencijama.